

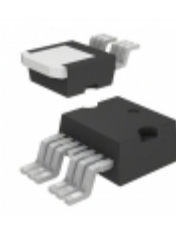







	<h2>STH260N6F6-6</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STH260N6F6-6</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 180A H2PAK-6</p> <p>Datenblätter:  STH260N6F6-6.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 732 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STH260N6F6-6
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 180A H2PAK-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	732 pcs Stock
Serie	DeepGATE™, STripFET™ VI
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D ² Pak (6 Leads + Tab)
Supplier Device-Gehäuse	H2PAK-6
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 60A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	183nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11800pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STH260N6F6-6 ist neu im Original, Suche STH260N6F6-6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STH260N6F6-6 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STH260N6F6-6: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>STH270N4F3-6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 180A H2PAK-6</p>	 <p>STH260N6F6-2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 180A H2PAK</p>	 <p>STH2610 STH STH2610 STH</p>	 <p>STH246025.1N LQFP LQFP 1328+</p>
 <p>STH250N6F3-6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 250A H2PAK</p>	 <p>STH270N4F3-2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 180A H2PAK-2</p>	 <p>STH250N55F3-6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 55V 180A H2PAK-6</p>	 <p>STH265N6F6-6AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 180A H2PAK-6</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ 06031A6R8CAT4A	↔ D689S18T	⇒ DCR1003SF14	D DD300KB120	⇒ DESI60-06A
⊣ GCM1885C2A7R2DA16D	⊗ GRM0225C1E120JA03L	D HAS300-S/SP52	⇒ IHLP1616BZER2R2M01	⇒ IRS2135J
⊗ KSH350TF	⊣ LMC6035IMX	⊗ LTC1326IS8	↔ MX29LV128DBT2C-90Q	⇒ NLV25T-1R5J-PF
D P4SMA400A-E3/61	⊗ S-93A56AD0A-J8T2GB	⊣ SA53994702	⊗ SMDJ33CA	⇒ STH12N60
⇒ STH12N60FI	↔ STH12NA60	⊗ STH12NA60FI	⊣ STH13NB60FI	⇒ STH14808-2
↔ STH15810-2	⇒ STH15NA50FI	D STH15NB50FI	⊗ STH160N4LF6-2	⊣ STH165N10F4-2
⊗ STH170N8F7-2	D STH180N10F3-2	⇒ STH270N4F3-6	↔ STH360N4F6-2	⇒ STH3N150-2
⊣ STH60N10	⊗ STH6N100	↔ STH6N100FI	⇒ STH6NA60FI	⇒ STH6NA80
⊗ STH80NF55-08	⊣ STHDLS101QTR	⊗ STHDLS101TQTR	D STHDMI001A	⇒ STHDMI001ATTR
↔ STHDMI002ABTR	⊗ STHVDAC-253MF3	⊣ STHVDAC-303F6	⊗ STHVDAC-303F6	⇒ VI-2NZ-IY

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited